

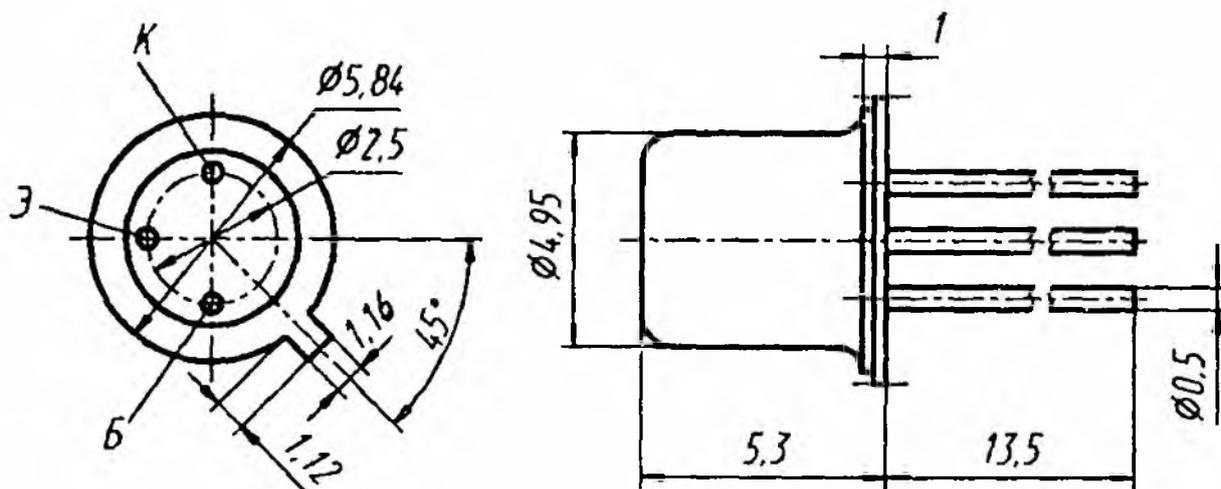
КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных, дифференциальных и импульсных усилителях, преобразователях. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

КТ501(А-М)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $U_{кз} = 1$ В, $I_k = 30$ мА:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| КТ501А, КТ501Г, КТ501Ж, КТ501Л | 20...60 |
| КТ501Б, КТ501Д, КТ501И, КТ501М | 40...120 |
| КТ501В, КТ501Е, КТ501К | 80...240 |

при $U_{кз} = 1$ В, $I_{к,и} = 0,5$ А, не менее

6

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5$ В, $I_k = 10$ мА, не менее

5 МГц

Коэффициент шума при $U_{кб} = 3$ В, $I_k = 0,2$ мА, $R_T = 3$ кОм, $f = 1$ кГц, не более

4 дБ

типичное значение

2* дБ

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
не более:

| | |
|--|-------|
| при $I_K = 0,3 \text{ А}$, $I_B = 0,06 \text{ А}$ | 0,4 В |
| при $I_{K, И} = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,1 \text{ А}$ | 0,7 В |

Напряжение насыщения база—эмиттер

| | |
|--|-------|
| при $I_K = 0,3 \text{ А}$, $I_B = 0,06 \text{ А}$, не более | 1,5 В |
|--|-------|

Обратный ток коллектор—эмиттер

| | |
|--|-------|
| при $U_{KЭР} = U_{KЭР, МАКС}$, $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, не более ... | 1 мкА |
|--|-------|

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = U_{БЭ, МАКС}$,

| | |
|----------------|-------|
| не более | 1 мкА |
|----------------|-------|

Емкость коллекторного перехода

| | |
|--|-------|
| при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $f = 500 \text{ кГц}$, не более | 50 пФ |
|--|-------|

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0,5 \text{ В}$,

| | |
|--|---------|
| $f = 500 \text{ кГц}$, не более | 100* пФ |
|--|---------|

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база

и коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ кОм}$,

$T = +25...+125 \text{ °С}$:

| | |
|------------------------------|------|
| КТ501А, КТ501Б, КТ501В | 15 В |
| КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е | 30 В |
| КТ501Ж, КТ501И, КТ501К | 45 В |
| КТ501Л, КТ501М | 60 В |

Постоянное напряжение база—эмиттер:

| | |
|---|------|
| при $T = -60...+125 \text{ °С}$ для КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е | 10 В |
| при $T = +25...+125 \text{ °С}$ для КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М | 20 В |

Постоянный ток коллектора

0,3 А

Импульсный ток коллектора

0,5 А

Постоянный ток базы

0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора при $T = -60...+35 \text{ °С}$

0,35 Вт

Температура $p-n$ перехода

+150 °С

Температура окружающей среды

-60...+125 °С

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт присоединяется первым и отключается последним.

Расстояние от места сгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм с радиусом закругления 1,5...2 мм. Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.